



第67回 半導体・集積回路技術シンポジウム

2004年12月16日(木)・17日(金)

機械振興会館ホール

第1日
12月16日(木)

- <9:25> 開会の挨拶 電子材料委員会委員長
- <9:30~10:20>
1. 招待講演 カーボンナノチューブの配線ビアへの応用
富士通研究所¹⁾、富士通²⁾：二瓶 瑞久^{1,2)}、川端 章夫^{1,2)}、
佐藤 信太郎^{1,2)}、近藤 大雄^{1,2)}、塩谷 広樹^{1,2)}、粟野 祐二^{1,2)}
- <10:20~10:45>
2. 無電解ボトムアップ銅めっきによるLSI配線形成
広島大学：新宮原 正三、王 増林、小畑 涼、
八重樫 道、坂上 弘之、高萩隆行
- <10:45~11:10>
3. 超純水電解加工(超純水のみによる電気化学的加工方法)のCuダマシ
ン平坦化プロセスへの適用開発
荏原製作所、荏原総合研究所*：野路 郁太郎、
小畠 徹貴、安田 穂積、飯泉 健、桑川 正行、和田 豊、
福永 明、辻村 学、當間 康*、鈴木 作*、際等 孝行*
- <11:10~12:00>
4. 招待講演 ポーラス low-k/Cu 配線対応の300mm CMP 技術
ノベラスシステムズジャパン、半導体先端テクノロジーズ*：
並木 明久、時藤 俊一*、尹普彦*、近藤 誠一*
- <12:00~13:00> 昼食
- <13:00~13:50>
5. 招待講演 PECVD-SiO₂CH膜のポア構造制御技術
NEC：林 喜宏
- <13:50~14:15>
6. リモートプラズマアッシングによるポーラスLow-k膜へのダメージ解析
日立：井上 修、神保 智子、勝山 清美、田丸 剛
- <14:15~14:40>
7. Low-k膜に対するアッシングダメージの評価
東レリサーチセンター、半導体先端テクノロジーズ*：関 洋文、
大塚 祐二、永井 直人、橋本 秀樹、島田 美代子、小川 真一
- <14:40~14:50> 休憩
- <14:50~15:15>
8. EBキュア技術を用いた45nm世代以降のSOD/Cuインテグレーション
東京エレクトロンAT、JSR、荏原製作所**：永井 洋之、前川 薫、岩下
光秋、村松 誠、久保田 和宏、日向 邦彦、小久保 輝一、塩田 淳、
服部 雅幸、永野 秀和、徳重 克彦、小寺 雅子、三島 浩二
- <15:15~15:40>
9. ALD-TaNを用いた高信頼Cuデュアルダマシ用バリアメタル構造の開発
ルネサステクノロジ：森 健壹、前川 和義、小林 清輝
- <15:40~16:50>
10. 招待講演 多層配線のスケーリングと65nm世代以降のCu/Low-k
プロセスインテグレーション技術
東芝：柴田 英毅

<17:00~18:30> -懇親会-

参加申込締切(予約) 12月8日(水)迄に申込書式に従い費用を添えて(現金書留または銀行振込・みずほ銀行大岡山支店
普通預金口座1926159 電子材料委員会小田俊理(オダシユリ)宛)お申込み下さい。 銀行振込の際も氏名、勤務先、連絡先をご連絡下さい。

参加登録費

予約 会員 20,000円 会員外 22,000円 大学関係 5,000円 学生 2,500円 (1日のみ 会員 14,000円 会員外 15,000円)
当日 会員 22,000円 会員外 24,000円 大学関係 6,000円 学生 3,000円 (1日のみ 会員 15,000円 会員外 16,000円)
講演論文集のみ希望の場合、1部6,000円でお分け致します。

参加申込、論文集申込先 〒102-0074東京都千代田区九段南4-8-30アルス市ヶ谷202

電気化学会電子材料委員会(TEL: 03-3234-4213 . FAX: 03-3234-3599)

第2日
12月17日(金)

- <10:20~11:10>
11. 招待講演 可変電源電圧と基板電圧制御による低電力65nmCMOS技術
NECエレクトロニクス、NEC：東郷 光洋、深井 利憲、中原 寧、
小山 晋、真壁 昌里子、長谷川 英司、永瀬 正俊、
松田 友子、坂本 圭司、藤原 秀二、後藤 啓郎、山本 豊二、
最上 徹、池田 昌弘、山縣 保司、今井 清隆、中柴 康隆
- <11:10~11:35>
12. 65nm CMOS技術へのDRAM混載インテグレーション
東芝、Sony*：安本 佳緒里、松原 義徳、土生 真理子、松田 聡、
本多 健二、森藤 英治、吉田 毅、国分 弘一、桜井 正臣、鈴木 泰成、
吉川 淳二、高橋 栄悦、檜山 薫、神田 昌彦、石塚 竜嗣、森内
真優美、古賀 洋貴、大野 圭一、福岡 勇三、十河康則、高橋 洋、
岡本 裕、長島 直樹、山田 誠司、野口 達夫
- <11:35~12:00>
13. 不純物ばらつきによるSRAMのスタティックノイズマージンに与える影
響の再検討
東京大学：橋 文彦、平本 俊郎
- <12:00~13:00> 昼食
- <13:00~13:50>
14. 招待講演 65nmノード以降の高信頼性CMOSプロセス技術
ルネサステクノロジ：山下 朋弘
- <13:50~14:40>
15. 招待講演 65nmノード低リークデバイス向けHfSiONトランジスタ技術
半導体先端テクノロジーズ：田村 泰之、峰地 輝、佐々木 隆興、泉 直希、
渡辺 俊成、小崎 浩司、大塚 文雄、安平 光雄、星 岳志、久米 聡、天井
秀美、井田 徹、青山 知憲、神山 聡、鳥居和功、北島 洋、有門 経敏
- <14:40~14:50> 休憩
- <14:50~15:15>
16. 45nmノード以降デバイス対応歪み制御素子分離技術
ルネサステクノロジ：石橋 真人、堀田 勝之、澤田 真人、北澤 雅志、
五十嵐 元繁、黒井 隆、柴森 貴尚、小林 清輝、犬石 昌秀、大路 謙
- <15:15~15:40>
17. ラジカル窒化酸化膜におけるNプロファイル制御
三菱電機¹⁾、ルネサステクノロジ²⁾、東北大学³⁾：河瀬 和雅^{1,3)}、
梅田 浩司²⁾、井上 真雄²⁾、辻川 真平²⁾、赤松 泰彦²⁾、諏訪
智之³⁾、樋口 正顕³⁾、小村 政則³⁾、寺本 章伸³⁾、大見 忠弘³⁾
- <15:40~16:30>
18. 招待講演 45nmCMOSプラットフォーム技術(CMOS6)
東芝：岩井 正明
- <16:30> 開会の挨拶

電気化学会電子材料委員会 主催

応用物理学会、高分子学会、精密工学会、電気学会、電子情報通信学会、日本印刷学会、日本化学会、
日本金属学会、日本セラミックス協会、日本写真学会、日本表面科学会、日本真空協会、ILKエレクトロニクス実装学会 協賛